# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

### TRAITE PT COOPERATION EN MATIET DE BREVETS

	Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL	
PCT	Destinataire:	
NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT D'UN CHANGEMENT  (règle 92bis.1 et instruction administrative 422 du PCT)  Date d'expédition (jour/mois/année)	LARDIC, René Thales Propriété Intellectuelle Département Brevets 13, avenue du Présisent Salvador Allende F-94117 Arcueil Cedex FRANCE	
20 février 2002 (20.02.02)		
Référence du dossier du déposant ou du mandataire 61833	NOTIFICATION IMPORTANTE	
Demande internationale no PCT/FR00/02306	Date du dépôt international (jour/mois/année) 11 août 2000 (11.08.00)	
Les renseignements suivants étaient enregistrés en ce qui c      X le déposant l'inventeur	le mandataire le représentant commun	
Nom et adresse THOMSON-CSF 173, boulevard Haussmann F-75008 Paris	Nationalité (nom de l'Etat) Domicile (nom de l'Etat)  FR FR  no de téléphone	
FRANCE	no de télécopieur	
	no de téléimprimeur	
2. Le Bureau international notifie au déposant que le changeme		
Nom et adresse THALES	Nationalité (nom de l'Etat) Domicile (nom de l'Etat) FR FR	
173, boulevard Haussmann F-75008 Paris FRANCE	no de téléphone	
	no de télécopieur	
	no de téléimprimeur	
3. Observations complémentaires, le cas échéant:		
4. Une copie de cette notification a été envoyée:		
À l'office récepteur     À l'administration chargée de la recherche internationale	aux offices désignés concernés  X aux offices élus concernés	
à l'administration chargée de l'examen préliminaire inte		
Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Fonctionnaire autorisé:  Sean Taylor	
no de télécopieur (41-22) 740 14 35	no de téléphone (41-22) 338.83.38	

Formulaire PCT/IB/306 (mars 1994)

004674720

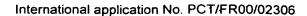
# TRAITE DE OPERATION EN MATIERE BREVETS

	Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL	
PCT	Destinataire:	
NOTIFICATION D'ELECTION (règle 61.2 du PCT)	Commissioner US Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202	
Date d'expédition (jour/mois/année) 20 juin 2001 (20.06.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE en sa qualité d'office élu	
PCT/FR00/02306	Référence du dossier du déposant ou du mandataire 61833	
Date du dépôt international (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)	
11 août 2000 (11.08.00)	20 août 1999 (20.08.99)	
Déposant		
JACQUET, Jean-Claude		
L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:      Ans la demande d'examen préliminaire international international le:      O5 mars 2001 (      dans une déclaration visant une élection ultérieure de		
2. L'élection X a été faite  n'a pas été faite  avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date à la règle 32.2b).	e de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé	
BEST AVAILABI	E COPY	

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse Fonctionnaire autorisé

Henrik Nyberg

no de téléphone: (41-22) 338.83.38

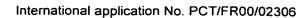




١. Basis of the report This report has been drawn up on the basis of the following elements (the replacement sheets received by the receiving office in response to an invitation according to Article 14 are considered in the present report as "originally filed" and are not annexed to the report as they contain no amendments (Rules 70.16 and 70.17).): Description, pages: as originally filed 1-15 Claims, No.: 1-17 as originally filed Drawings, sheets: 1/7-7/7 as originally filed 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3). 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application. the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: contained in the international application in written form. filed together with the international application in computer readable form. furnished subsequently to this Authority in written form. furnished subsequently to this Authority in computer readable form. The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written

sequence listing has been furnished.





		•						,
4.	The	e amendments have	e resulted in	n the cance	ellation of:			
		the description	n, pages					
		☐ the claims,	Nos.	o.				
		☐ the drawings,	sheets/fig					
5.		This report has be going beyond the	een written descriptior	disregardir	ng (some of) ention, as file	the amendme	nts, which were o	considered as 70.2(c)):
		(All replacement s attached to this re	sheets com eport).	prising am	endments of	this nature sh	ould be indicated	l in point 1 and
6.	Add	litional observations	s, if necess	ary:				
V.	Rea app	soned statement	under A s and expl	rticle 35(2) anations s	) with rega supporting s	ird to novelt such statemer	y, inventive st nt	ep or industria
1.	Stat	ement						
	٨	Novelty		Yes: No:	Claims Claims	1-17		
	li	nventive Step		Yes: No:	Claims Claims	1-17		
	Ir	ndustrial Applicabilit	ty	Yes: No:	Claims Claims	1-17		
2.	Citat	tions and explanatio	ons					
	see	separate sheet						
VII.	Cert	ain defects in the	internation	nal applica	ation			
The	foliow	ving defects in the fo	orm or cont	tents of the	internationa	al application h	ave been noted:	
see	sepa	rate sheet						

### In the matter of point V

Reasoned statement according to Article 35(2) as to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations in support of this declaration

1. Reference is made to the following document:

D1: EP-A-0436424

D1 is the same family of applications as FR-A-2656723 discussed in the present description (see p.1 1.21-23).

- 2. D1 describes a read head according to the preamble of the present first claim (see col.3 1.1-20 and figure 2).
- 3. The present application addresses the problem of differential wear between the various materials of the head (see p.3 1.11-p.4 1.22).
- 4. However, for example, D1 does not deal with this problem, and does not propose a suitable technology.
- 5. Thus, the subject matter of the first claim and, consequently, the dependent claims, involve an inventive step.

# In the matter of point VII Irregularities in the International application

1. The reference sign "9" is not used correctly in 1.5 of claim 1 (R.6.2(b) and R.10.2).

Daz

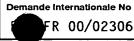
# TRAITE DE COPPERATION EN MATIERE DE BREVETS PCT

### RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire 61833	POUR SUITE voir la notification de trans (formulaire PCT/ISA/220) d	mission du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, le point 5 ci-après
Demande internationale n°	Date du dépôt international (jour/mois/année)	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année)
PCT/FR 00/02306	11/08/2000	20/08/1999
Déposant		
THOMSON-CSF		
Le présent rapport de recherche internation déposant conformément à l'article 18. Une	onale, établi par l'administration chargée de la re e copie en est transmise au Bureau internationa	echerche internationale, est transmis au al.
Ce rapport de recherche internationale co	mprend2 feuilles. d'une copie de chaque document relatif à l'état d	de la technique qui y est cité.
Base du rapport		
<ul> <li>a. En ce qui concerne la langue, la langue dans laquelle elle a été dé</li> </ul>	recherche internationale a été effectuée sur la t posée, sauf indication contraire donnée sous le	base de la demande internationale dans la e même point.
la recherche international	e a été effectuée sur la base d'une traduction d	le la demande internationale remise à l'administration.
la recherche internationale a été e	es de nucléotides ou d'acides aminés divulgo effectuée sur la base du listage des séquences e internationale, sous forme écrite.	uées dans la demande internationale (le cas échéant), :
	e internationale, sous forme déchiffrable par ord	dinateur.
remis ultérieurement à l'a	dministration, sous forme écrite.	
remis ultérieurement à l'a	dministration, sous forme déchiffrable par ordin	nateur.
La déclaration, selon laque divulgation faite dans la d	relle le listage des séquences présenté par écri emande telle que déposée, a été fournie.	it et fourni ultérieurement ne vas pas au-delà de la
La déclaration, selon laqu		déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles
2. Il a été estimé que certa	ines revendications ne pouvaient pas faire l	l'objet d'une recherche (voir le cadre I).
3. Il y a absence d'unité de	e l'invention (voir le cadre II).	
4. En ce qui concerne le <b>titre,</b>		
X le texte est approuvé tel d	qu'il a été remis par le déposant.	
Le texte a été établi par l'	administration et a la teneur suivante:	
5. En ce qui concerne l'abrégé,		
1 1 1 1	qu'il a été remis par le déposant	
présenter des observatio		ormément à la règle 38.2b). Le déposant peut compter de la date d'expédition du présent rapport
de recherche internationa 6. La figure des dessins à publier avec		5
X suggérée par le déposan	t.	Aucune des figures
parce que le déposant n'	a pas suggéré de figure.	n'est à publier.
parce que cette figure ca	ractérise mieux l'invention.	

### RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



			FR 00,	/02306
A. CLASSEI CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE G11B11/105			
Selon la clas	sification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classifica	ation nationale et la C	CIB	
	ES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE			
Documentati CIB 7	ion minimale consultée (système de classification suivi des symboles d $G11B$	e classement)		
	ion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où			
Base de don	nées électronique consultée au cours de la recherche internationale (n	om de la base de doi	nnées, et si réalisab	le, termes de recherche utilisés)
EPO-In	ternal, PAJ			
C. DOCUME	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication c	les passages pertiner	nts	no. des revendications visées
Α	EP 0 436 424 A (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS) 10 juillet 1991 (1991-07-10) cité dans la demande colonne 3, ligne 1 - ligne 30			1
Α	EP 0 527 670 A (THOMSON CSF) 17 février 1993 (1993-02-17) colonne 4, ligne 28 -colonne 5, ligne 17			1
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documen	nts de familles de bro	evets sont indiqués en annexe
Ш	o spáciales de dovuments citás:	document ultérieur	publié après la date	e de dépôt international ou la
*A' document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date  *L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de date de priorité et n'apparlenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théone constituant la base de l'invention  *X' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une act inventive par rapport au document considéré isolément				imprendre le principe nvention inven tion revendiquée ne peut comme impliquant une activité nsidéré isolément
priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)  'O' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens  'P' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier  '&' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier  '&' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée				
	'éleurement à la date de priorité revendiquée 'élelle la recherche internationale a été effectivement achevée	<u>·</u> <u>·</u>		de recherche internationale
·	décembre 2000	11/12/2		
Nom et adre	sse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2	Fonctionnaire auto	orisé	
	Office European des Brevers, F.B. 3616 Fatermazi 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Nanos,	Α	

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

	Application No 00/02306
nih	Publication

<i>\                                    </i>	Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
	EP 0436424	A	10-07-1991	AT CA DE 69 DE 69 DK ES WO GR JP KR	2656723 A 142817 T 2047185 A 9028510 D 9028510 T 436424 T 2091234 T 9110234 A 3021145 T 4504922 T 230668 B 5689391 A	05-07-1991 15-09-1996 29-06-1991 17-10-1996 06-02-1997 03-03-1997 01-11-1996 11-07-1991 31-12-1996 27-08-1992 15-11-1999 18-11-1997
	EP 0527670	Α	17-02-1993	DE 69 DE 69 EP 0 JP 0	2680268 A 9227486 D 9227486 T 0844604 A 6180883 A 5392181 A	12-02-1993 10-12-1998 15-04-1999 27-05-1998 28-06-1994 21-02-1995

### PATENT COOPERATION TREATY

# **PCT**

### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or Agent's file reference 61833	FOR FURTHER ACTION		n of Transmittal of International Preliminary eport (Form PCT/IPEA/416)			
International application No. PCT/FR00/02306	International filing date (da 11/08/2000	ay/month/year)	Priority date (day/month/year) 20/08/1999			
International Patent Classification (IPC) or na G11B11/105	tional classification and IPC	С				
Applicant THOMSON-CSF et al.						
<ol> <li>This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</li> <li>This REPORT consists of a total of 4 sheets including this title page.</li> <li>This report is also accompanied by ANNEXES, i.e. sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Instruction 607 of Administrative Instructions of the PCT).</li> <li>These annexes consist of a total of sheets.</li> </ol>						
This report contains indications relating t	3. This report contains indications relating to the following items:					
I ⊠ Basis of the report						
II 🖂 Priority						
III   Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability			nd industrial applicability			
IV 📋 Lack of unity of invention	on					
V  Reasoned statement according to Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability citations and explanations supporting such statement			elty, inventive step or industrial applicability;			
VI 🔲 Certain documents cite	ed					
VII ⊠ Certain defects in the in	nternational application					
VIII   Certain observations or	n the international applicati	tion				
Date of submission of the demand	Da	ate of completion of	this report			

Date of subr 05/03/2001	nission of the demand	Date of completion of this report 25.07.2001	
Name and n	European Patent Office D-80298 Munich Tel. +49 89 2399-0, Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399-4465	Authorized officer: Poth, H Telephone No. +49 89 2399 2149	

AVIS INFORMANT LE DEPOSANT DE LA COMMUNICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE AUX OFFICES DESIGNES

(règle 47.1.c), première phrase, du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

LARDIC, René

Thomson-CSF Propriété

Intellectuelle

Département Brevets

13, avenue du Présisent Salvador

Allende

F-94117 Arcueil Cedex

**FRANCE** 

Date d'expédition (jour/mois/année)

01 mars 2001 (01.03.01)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

61833

AVIS IMPORTANT

Demande internationale no PCT/FR00/02306

Date du dépôt international (jour/mois/année) Date de priorité (jour/mois/année)

11 août 2000 (11.08.00)

20 août 1999 (20.08.99)

Déposant

THOMSON-CSF etc

1. Il est notifié par la présente qu'à la date indiquée ci-dessus comme date d'expédition de cet avis, le Bureau international a communiqué, comme le prévoit l'article 20, la demande internationale aux offices désignés suivants: KR,US

Conformément à la règle 47.1.c), troisième phrase, ces offices acceptent le présent avis comme preuve déterminante du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu à la date d'expédition indiquée plus haut, et le déposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale à l'office ou aux offices désignés.

2. Les offices désignés suivants ont renoncé à l'exigence selon laquelle cette communication doit être effectuée à cette date: EP,JP,NO

La communication sera effectuée seulement sur demande de ces offices. De plus, le déposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale aux offices en question (règle 49.1)a-bis)).

3. Le présent avis est accompagné d'une copie de la demande internationale publiée par le Bureau international le 01 mars 2001 (01.03.01) sous le numéro WO 01/15155

### RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31.2)a) et règle 54.2)

Si le déposant souhaite reporter l'ouverture de la phase nationale jusqu'à 30 mois (ou plus pour ce qui concerne certains offices) à compter de la date de priorité, la demande d'examen préliminaire international doit être présentée à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité.

Il appartient exclusivement au déposant de veiller au respect du délai de 19 mois.

Il est à noter que seul un déposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lié par le chapitre Il ou qui y a son domicile peut présenter une demande d'examen préliminaire international.

### RAPPEL CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (article 22 ou 39.1))

Si le déposant souhaite que la demande internationale procède en phase nationale, il doit, dans le délai de 20 mois ou de 30 mois, ou plus pour ce qui concerne certains offices, accomplir les actes mentionnés dans ces dispositions auprès de chaque office désigné ou élu.

Pour d'autres informations importantes concernant les délais et les actes à accomplir pour l'ouverture de la phase nationale, voir l'annexe du formulaire PCT/IB/301 (Notification de la réception de l'exemplaire original) et le volume II du Guide du déposant du PCT.

> Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse

Fonctionnaire autorisé

J. Zahra

no de télécopieur (41-22) 740.14.35

no de téléphone (41-22) 338.83.38

### PCT

# NOTIFICATION RELATIVE A LA PRESENTATION OU A LA TRANSMISSION DU DOCUMENT DE PRIORITE

(instruction administrative, 411 du PCT)

Expéditeur : le BUREAU INTERNATIONAL

#### Destinataire:

LARDIC, René Thomson-CSF Propriété Intellectuelle Département Brevets 13, avenue du Présisent Salvador Allende F-94117 Arcueil Cedex FRANCE

FRANCE		
NOTIFICATION IMPORTANTE		
Date du dépôt international (jour/mois/année) 11 août 2000 (11.08.00)		
Date de priorité (jour/mois/année) 20 août 1999 (20.08.99)		

Deposant

### THOMSON-CSF etc

- 1. La date de réception (sauf lorsque les lettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des documents de priorité correspondant à la ou aux demandes énumérées ci-après est notifiée au déposant. Sauf indication contraire consistant en un astérisque figurant à côté d'une date de réception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite, le document de priorité en question a été présenté ou transmis au Bureau international d'une manière conforme à la règle 17.1.a) ou b).
- 2. Ce formulaire met à jour et remplace toute notification relative à la présentation ou à la transmission du document de priorité qui a été envoyée précédemment.
- 3. Un astérisque(\*) figurant à côté d'une date de réception dans la colonne de droite signale un document de priorité présenté ou transmis au Bureau international mais de manière non conforme à la règle 17.1.a) ou b). Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.
- 4. Les lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorité que le Bureau international n'a pas reçu ou que le déposant n'a pas demandé à l'office récepteur de préparer et de transmettre au Bureau international, conformément à la règle 17.1.a) ou b), respectivement. Dans ce cas, l'attention du déposant est appelée sur la règle 17.1.c) qui stipule qu'aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.

Date de priorité Demande de priorité n

Pays, office régional ou office récepteur selon le PCT

Date de réception du document de priorité

20 août 1999 (20.08.99) 99/10671

FR

26 sept 2000 (26.09.00)

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse Fonctionnaire autorisé:

Dorothée Mülhausen

no de téléphone (41-22) 338.83.38

# TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

**PCT** 

REC'D 27 JUL 2001

# RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

PCT

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire 61833	POUR SUITE A DONNER	voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)				
Demande internationale n°	Date du dépot international (jour/moi	s/année) Date de priorité (jour/mois/année)				
PCT/FR00/02306	11/08/2000	20/08/1999				
Classification internationale des brevets (CIB) G11B11/105	Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB					
Déposant						
THOMSON-CSF et al.						
Le présent rapport d'examen prélimi international, est transmis au déposa	naire international, établi par l'adr ant conformément à l'article 36.	ninistaration chargée de l'examen préliminaire				
2. Ce RAPPORT comprend 4 feuilles,	y compris la présente feuille de co	ouverture.				
été modifiées et qui servent de l	été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).					
Le présent rapport contient des indic	ations relatives aux points suivan	ts:				
I ⊠ Base du rapport						
II  Priorité	all and the second					
III ☐ Absence de formulation d'application industrielle	d'opinion quant à la nouveauté, l'a	activité inventive et la possibilité				
IV 🔲 Absence d'unité de l'inve	ention	tion				
V 🛛 Déclaration motivée selo d'application industrielle;	n l'article 35(2) quant à la nouvea citations et explications à l'appui	uté, l'activité inventive et la possibilité de cette déclaration				
VI   Certains documents cités	s					
VII 🛛 Irrégularités dans la dem						
VIII ☐ Observations relatives à	la demande internationale					
Date de présentation de la demande d'examen internationale	préliminaire Date d'achè	evement du présent rapport				
05/03/2001	25.07.2001					
Nom et adresse postale de l'administration char l'examen préliminaire international:	gée de Fonctionnai	re autorisé				
Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 e Fax: +49 89 2399 - 4465		none +49 89 2399 2149				

### I. Base du rapport

1. En ce qui concerne les éléments de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées dans le présent rapport comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17)): Description, pages: 1-15 version initiale Revendications, N°: 1-17 version initiale Dessins, feuilles: 1/7-7/7 version initiale 2. En ce qui concerne la langue, tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point. Ces éléments étaient à la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: , qui est : ☐ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)). ☐ la langue de publication de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)). ☐ la langue de la traduction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou 55.3). 3. En ce qui concerne les séquences de nucléotides ou d'acide aminés divulguées dans la demande internationale (le cas échéant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des séquences: ☐ contenu dans la demande internationale, sous forme écrite. ☐ déposé avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur. remis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite. remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur. ☐ La déclaration, selon laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie. ☐ La déclaration, selon laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles du listages des séquences Présenté par écrit, a été fournie.

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres I-VIII, feuille 1) (juillet 1998)

4. Les modifications ont entraîné l'annulation :

		de la description,	pages:		
		des revendications,	n <sup>os</sup> :		
		des dessins,	feuilles :		
5.		Le présent rapport a comme allant au-dela 70.2(c)) :	été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées à de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle		
		(Toute feuille de rem annexée au présent	placement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 e rapport)		
6.	Obs	Observations complémentaires, le cas échéant :			
٧.	Déc d'ap	laration motivée selo plication industrielle	on l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité e; citations et explications à l'appui de cette déclaration		

1. Déclaration

Nouveauté Oui : Revendications 1-17

Non: Revendications

Activité inventive Oui : Revendications 1-17

Non: Revendications

Possibilité d'application industrielle Oui : Revendications 1-17

Non: Revendications

2. Citations et explications voir feuille séparée

### VII. Irrégularités dans la demande internationale

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont été constatées : voir feuille séparée

### Concernant le point V

Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Il est fait référence au document suivant:

D1: EP-A- 0436424

D1 est de la même famille de demandes que FR-A-2656723 évoqué dans la présente description (v. p.1 l.21-23).

- 2. D1 décrit une tête de lecture selon le préambule de la présente première revendication (v. col.3 l.1-20 et figure 2).
- 3. La présente demande s'adresse au problème de l'usure différentielle entre les différents matériaux de la tête (v. p.3 l.11-p.4 l.22).
- 4. Mais p. ex. D1 ne traite pas ce problème, et ne propose pas une technologie appropriée.
- 5. Ainsi, le sujet de la première revendication et, par conséquent, les revendications dépendantes impliquent une activité inventive.

### Concernant le point VII

Irrégularités dans la demande internationale

1. Le signe de référence "9" n'est pas utilisé correctement à la I.5 de la revendication 1 (R.6.2(b) et R.10.2).

### , PATENT COOPERATION TREATY

Translation

### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

**PCT** 

(PCT Article 36 and Rule 70)

Cuic	(	01	0	14	9	91	10
·	NI'C			Т	:	~.	_ Into-

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No. PCT/FR00/02306	International filing date (day/montal) 11 August 2000 (11.08.6				
International Patent Classification (IPC) of G11B 11/105	national classification and IPC				
Applicant	THALES				
Authority and is transmitted to the  2. This REPORT consists of a total of	e applicant according to Article 36.  of 4 sheets, including the	I by this International Preliminary Examining his cover sheet.			
been amended and are the (see Rule 70.16 and Secti	e basis for this report and/or sheets con on 607 of the Administrative Instruction a total of sheets.	taining rectifications made before this Authority			
3. This report contains indications relating to the following items:    I					
Date of submission of the demand 05 March 2001 (05		25 July 2001 (25.07.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/E	P Authorized	Authorized officer			
Facsimile No.	Telephone	Telephone No.			

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)

International application No.

### PCT/FR00/02306

### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

			101/1100/02300				
I. Basis of the report							
1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):							
$\boxtimes$	the international	application as originally filed.					
	the description,	pages 1-15	_, as originally filed,				
		pages	_, filed with the demand,				
			_, filed with the letter of				
		pages					
	the claims,	Nos. <u>1-17</u>	_ , as originally filed,				
		Nos.	, as amended under Article 19.				
		Nos.	_ , filed with the demand,				
		Nos.	_ , filed with the letter of ,				
		Nos.	, filed with the letter of				
	the drawings,	sheets/fig1/7-7/7	_ , as originally filed,				
		sheets/fig	_ , filed with the demand,				
		sheets/fig	_ , filed with the letter of ,				
		sheets/fig	, filed with the letter of				
2. The amend	lments have resulte	ed in the cancellation of:					
	the description,	pages					
	the claims,	Nos.					
	the drawings,	sheets/fig					
This	report has been e	stablished as if (some of) the an	nendments had not been made, since they have been considered				
			e Supplemental Box (Rule 70.2(c)).				
4. Additional	observations, if no	ecessary:					
	·	•					
			-				
		. ,					

THIS PAGE BLANK (USPTC)

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/FR 00/02306

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement						
. Statement						
Novelty (N)		Claims	1-17	YES		
		Claims		NO		
Inventive step (IS)	ep (IS)	Claims	1-17	YES		
		Claims		NO		
Industrial applicability (IA)	plicability (IA)	Claims	1-17	YES		
		Claims		NO		

2. Citations and explanations

Reference is made to the following document:

D1: EP-A-0436424

D1 is of the same category of applications as FR-A-2656723, mentioned in the present description (see page 1, lines 21-23).

- 2. D1 describes a reading head according to the preamble of the present first claim (see column 3, lines 1-20 and Figure 2).
- 3. The present application addresses the problem of differential wear between the different materials of the head (see page 3, line 11 to page 4, line 22).
- However, D1, for example, does not address this problem, and does not propose a suitable device.
- 5. Thus, the subject matter of the first claim and therefore the dependent claims involves an inventive step.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/FR 00/02306

e following defects in the form or contents of the international application have been noted:					
The reference sign "9" is not used correctly in					
line 5 of Claim 1 (PCT Rules $6.2(b)$ and $10.2$ ).					



### (12) DEMANDE INTER-TIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

### (19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





### (43) Date de la publication internationale 1 mars 2001 (01.03.2001)

### **PCT**

# (10) Numéro de publication internationale WO 01/15155 A1

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>:

G11B 11/105

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/02306

- (22) Date de dépôt international: 11 août 2000 (11.08.2000)
- (25) Langue de dépôt:

français

(26) Langue de publication:

français

- (30) Données relatives à la priorité: 99/10671 20 août 1999 (20.08.1999)
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): THOM-SON-CSF [FR/FR]; 173, boulevard Haussmann, F-75008 Paris (FR).

- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): JACQUET, Jean-Claude [FR/FR]; Thomson-CSF Propriété Intellectuelle, Département Brevets, 13, avenue du Prés. Salvador Allende, F-94117 Arcueil Cedex (FR).
- (74) Mandataire: LARDIC, René; Thomson-CSF Propriété Intellectuelle, Département Brevets, 13, avenue du Présisent Salvador Allende, F-94117 Arcueil Cedex (FR).
- (81) États désignés (national): JP, KR, NO, US.
- (84) États désignés (régional): brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

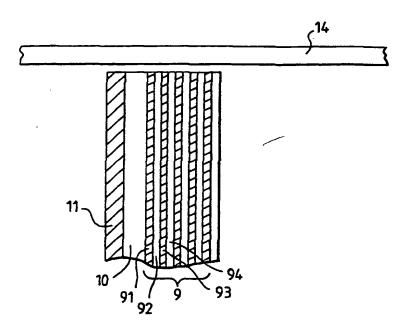
#### Publiée:

Avec rapport de recherche internationale.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: ANTI-ABRASIVE READING HEAD

(54) Titre: TETE DE LECTURE ANTI-ABRASION



(57) Abstract: The invention concerns a magneto-optical reading head comprising a magneto-optical transducer with a multilayer structure (9 to 11) with at least one thin magnetic layer with magneto-optical effect (11), at least one non-magnetic layer (10) having a predetermined coefficient of wear and a layer with good magnetic permeability (9) closing the magnetic circuit. The layer with good magnetic permeability comprises an alternating first sub-layers (91, 93) made of magnetic material with good magnetic permeability and second sub-layers (92, 94) made of material having a coefficient of wear substantially equivalent to said coefficient of wear of the non-magnetic layer (10).

WO 01/15155 A1





En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) Abrégé: Tête de lecture magnéto-optique comportant un transducteur magnéto-optique à structure multicouches (9 à 11) à au moins une couche magnétique mince à effet magnéto-optique (11), au moins une couche en matériau non magnétique (10) et présentant un coefficient d'usure déterminé et une couche à bonne perméabilité magnétique (9) de fermeture de circuit magnétique. La couche à bonne perméabilité magnétique comprend une alternance de premières sous-couches (91, 93) en matériau magnétique à bonne perméabilité magnétique et de deuxièmes sous-couches (92, 94) en matériau présentant un coefficient d'usure sensiblement équivalent audit coefficient d'usure de la couche en matériau non magnétique (10).

15

20

25

30

### TETE DE LECTURE ANTI-ABRASION

La présente invention se rapporte à une tête de lecture magnétooptique.

Pour la lecture de support magnétique, un type connu de têtes magnéto-optiques met en œuvre un effet Faraday et/ou un effet Kerr. Ces effets consistent à magnétiser un matériau magnéto-optique, tel que du grenat, par le flux magnétique produit par le support magnétique, et à détecter cette magnétisation grâce au pouvoir rotatoire qu'elle a sur une lumière polarisée.

Le principe physique exploité est l'effet magnéto-optique, connu sous le nom de rotation Kerr ou de rotation Faraday. Dans cet effet, une onde électromagnétique se réfléchissant sur un milieu magnéto-optique ou le traversant, subit une modification de son état de polarisation. Cet état dépend de la direction de l'aimantation du milieu. Le pôle de lecture étant constitué d'un tel matériau, un faisceau laser s'y réfléchissant voit sa polarisation modulée par les variations d'aimantations induitent par le support magnétique. Cette modulation est ensuite transformée en variations d'intensité lumineuse qui sont alors mesurées à l'aide d'un photodétecteur permettant ainsi de remonter à l'information inscrite sur le support magnétique. L'information magnétique n'est donc plus véhiculée par un courant électrique mais par une onde électromagnétique.

Une telle tête de lecture a été décrite dans le brevet français n° 2 656 723. La figure 1 représente le schéma simplifié d'un mode de réalisation de cette tête.

Elle comporte une couche 9 de matériau magnétique à bonne perméabilité magnétique, d'une épaisseur pouvant atteindre plusieurs microns par exemple.

Sur la couche 9 sont formées une couche 10 de matériau non magnétique, d'une épaisseur comprise, par exemple entre 50 et 3 000 nm, et typiquement de 300 nm environ, et une couche mince 11 de matériau magnétique formant la couche à effet magnéto-optique (effet Kerr par exemple). L'épaisseur de la couche 11 est par exemple comprise entre 10 et 200 nm environ. Un faisceau optique incident oblique 12 arrive sur la couche 11, qui réfléchit un faisceau 13. Les couches 9 à 11 sont polies sur un de

25

30

35

leurs chants, par exemple perpendiculairement à leur surface principale, et la bande magnétique à lire 14 est appliquée sur la surface ainsi polie.

La tête de la figure 1 peut être facilement réalisée en une seule opération de dépôt de couches, et il n'est pas absolument nécessaire de graver les couches déposées, pour réaliser des têtes de lecture multipistes.

On a représenté en figure 2 un système 20 de lecture magnétooptique multipiste comportant une tête de lecture conforme à l'invention.
L'intérêt principal, pour la lecture d'un enregistrement multipiste, de
l'utilisation d'une tête à effet Kerr est dû au principe de la lecture active dont
les performances ne sont pas handicapées par une faible vitesse de
défilement de la bande à lire. Le système 20 comporte en amont de la tête
21 à effet Kerr une source ponctuelle de lumière 22, de préférence une diode
laser, un objectif de collimation 23, un dispositif 24 comprenant un polariseur
servant à rendre la polarisation du faisceau lumineux la traversant
perpendiculaire à la direction de défilement de la bande 25 à lire, et une
lentille cylindrique 26 orientée de façon à focaliser le faisceau collimaté par
l'objectif 23 selon une ligne perpendiculaire à la direction de défilement de la
bande 25.

La tête 21 comprend, comme exposé dans la présente description, un capteur à effet Kerr et, le cas échéant, un réflecteur optique.

En aval de la tête 21, le système 20 comporte un dispositif optique 27 d'imagerie; un dispositif 28 comprenant un analyseur et le cas échéant un compensateur de phase; et un capteur optique linéaire 29 dont la zone active est la conjuguée optique par le système optique, de la ligne éclairée sur la tête à effet Kerr. Ce capteur optique comporte par exemple une barrette CCD. Le grandissement de la partie aval du système 20 étant typiquement de l'ordre de l'unité, on peut avantageusement le réaliser en optique intégrée.

La figure 3 représente un mode de réalisation d'une tête de lecture magnéto-optique selon l'invention dans lequel les différentes couches de la figure 1 sont réalisées sur un prisme 35 en matériau transparent à la longueur d'onde du faisceau de lecture. Ce matériau est par exemple en SGGG (Grenat de Galidonium et Gallium). Les différentes faces 30 à 33 de ce prisme sont orientées de façon que le faisceau de lecture 12 pénètre sans réflexion dans le prisme et soit réfléchi sur la face 32 portant la couche

magnéto-optique 11 de la tête, à proximité de la zone de lecture de la bande magnétique 14 à lire. La face de sortie 33 est orientée de façon que le faisceau 13 sorte sans réflexion du prisme. Il est à noter que les faces 30 et 33 peuvent être revêtues d'une couche de matériau antireflet en SiO<sub>2</sub> par exemple.

Les couches 9, 10, 11 correspondent aux couches portant les mêmes références sur la figure 1 sont réalisées sur la face 32 du prisme.

Dans ce type de têtes magnétiques connues, la couche magnétooptique 11 est en Sendust (Fe<sub>x</sub>Si<sub>y</sub>Al<sub>z</sub>), la couche d'entrefer 10 est en Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 10 ou Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> et la couche magnétique 9 est en Sendust.

A titre d'exemple, une tête de lecture magnéto-optique peut être actuellement constituée de l'empilement des matériaux suivants :

- une couche 11 de Sendust, d'une épaisseur de 30 nm et qui sert de pôle de lecture,
- une couche de Nitrure de Silicium de 180 nm d'épaisseur,
- une couche de Cuivre de 50 nm d'épaisseur

ces deux couches servant de couche d'entrefer magnétique et optique 10.

20

15

- une couche 9 de Sendust de 1 μm d'épaisseur permettant de fermer le flux et jouant un rôle de blindage magnétique,
- une couche d'alumine ou de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ou de tout autre matériau dur non magnétique de 2 µm d'épaisseur peut être prévue pour servir de protection de l'ensemble.

25

Le tout est déposé sur un substrat de Grenat.

Ces matériaux de nature très différente ont tous des propriétés mécaniques différentes. Ainsi, nous avons une association de matériaux durs (Grenat, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) et de matériaux tendre (Sendust, Cuivre). Cette constitution de matériaux de duretés très différentes est extrêmement pénalisante en terme de durée de vie du composant. En effet, au contact de la bande, nous observons un phénomène d'usure différentielle entre les matériaux durs et doux avec l'apparition d'une récession de l'ordre de 100 nm des matériaux les moins durs, celle-ci étant essentiellement localisée sur

15

20

25

30

la couche 9 (voir figure 4a). Cette usure est représentée sur les figures 4a et 4b. Dans le cas où la couche 9 est recouverte d'une couche 10b de dureté supérieure à celle de la couche 9, on peut avoir une usure telle que représentée en figure 4b. Cette usure peut être sensible au bout de quelques 5 centaines d'heures d'utilisation seulement, alors que l'on désire avoir de 5 000 à 30 000 heures de fonctionnement selon l'application visée. Cette récession se traduit par une perte de signal d'environ 6 dB à 1µm de longueur d'onde magnétique suite à l'espacement créé et à la perte de résolution, la tête passant progressivement d'un fonctionnement dipolaire où la résolution est déterminée par la largeur du gap à un fonctionnement monopolaire où la résolution est alors déterminée par l'extension de la zone active du pôle de lecture.

Il est alors impossible de récupérer le signal, la partie en contact étant irrémédiablement détériorée et seul un refaçonnage du méplat permettrait de récupérer ce signal.

Dans les têtes de lecture/écriture magnétorésistives, les solutions actuelles proposent de déposer une couche d'un matériau dur sur le devant de la tête. Cependant, cette solution est contraignante et coûteuse en terme de réalisation technologique (les matériaux durs difficiles à réaliser), et génère des pertes d'espacement de l'ordre de 3 à 4 dB à 1µm (pour 60 nm déposés).

L'invention vise à résoudre ce problème d'usure.

L'invention concerne donc une tête de lecture magnéto-optique, caractérisée par le fait qu'elle comporte un transducteur magnéto-optique à structure multicouches à au moins une couche magnétique mince à effet magnéto-optique, au moins une couche en matériau non magnétique et présentant un coefficient d'usure déterminé et une couche à bonne perméabilité magnétique de fermeture de circuit magnétique, caractérisée en ce que la couche à bonne perméabilité magnétique comprend une alternance de premières sous-couches en matériau magnétique à bonne perméabilité magnétique et de deuxièmes sous-couches en matériau présentant un coefficient d'usure sensiblement équivalent audit coefficient d'usure de la couche en matériau non magnétique.

10

15

30

35

Les différents objets et caractéristiques de l'invention apparaîtront plus clairement dans la description qui va suivre fournie à titre d'exemple et dans les figures annexées qui représentent :

- les figures 1 à 4, des têtes de lecture magnéto-optiques selon l'art connu et décrites précédemment;
- la figure 5, un exemple simplifié de tête de lecture magnétooptique selon l'invention;
- la figure 6, un exemple de réalisation des différentes couches de la tête de lecture de la figure 5 ;
- les figures 7a et 7b, un exemple plus complet d'une tête de lecture selon l'invention ;
- les figures 8 à 11, un mode de réalisation de la tête de lecture permettant de symétriser la structure de la tête.

En se reportant à la figure 5, on va donc tout d'abord décrire un exemple simplifié d'une tête de lecture magnéto-optique selon l'invention.

Cette tête de lecture comporte, comme décrit précédemment, une couche 11 en matériau présentant des propriétés magnéto-optique (effet Kerr et/ou effet Faraday), une couche d'entrefer 10 en matériau non magnétique, une couche 90 en matériau magnétique ayant bonne perméabilité magnétique pour permettre au flux magnétique induit par le support magnétique 14 de circuler et de se refermer par les couches 11 et 9.

Selon l'invention, la couche 9 est constituée par un empilement de sous-couches (telles que 91, 93) en matériau à bonne perméabilité magnétique alternées avec des sous-couches (telles que 92, 94) ayant un coefficient d'usure sensiblement équivalent à celui de la couche d'entrefer 10. De préférence, ce coefficient d'usure est faible.

De préférence, les sous-couches en matériau à bonne perméabilité magnétique sont en un matériau similaire à celui de la couche 11. Les sous-couches en matériau à coefficient d'usure équivalent à celui de la couche 10 sont en matériau similaire à celui de la couche d'entrefer 10.

De cette façon, les couches 9 et 10 s'useront de façon uniforme et le phénomène d'usure de la figure 4 ne se produira pas.

La figure 6 représente un exemple de réalisation d'une telle tête de lecture. Selon cet exemple, la couche 11 est en Sendust (Fe<sub>x</sub>Si<sub>y</sub>Al<sub>z</sub>) d'épaisseur environ 25 nm, la couche d'entrefer 10 est en nitrure de Silicium

10

20

25

30

(Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub>) d'épaisseur environ 200 nm et la couche 9 est une alternance de couches de Sendust de 30 nm d'épaisseur et de couches de Nitrure de Silicium d'épaisseur 20 nm. Par exemple, la couche 9 peut être constituée d'une trentaine de couches de Sendust et d'une trentaine de couches de Nitrure de Silicium.

On voit donc, que selon l'invention, pour réduire les problèmes de rétreint du deuxième pôle (couche 9), nous partons de la constatation que la valeur de celui-ci dépend de l'épaisseur du matériau magnétique, le rétreint diminuant lorsque l'épaisseur diminue. Ainsi plus l'épaisseur du matériau en contact avec la bande sera faible, plus l'usure de ce matériau sera réduite. Cela explique pourquoi la couche 11 est beaucoup moins affectée par ce phénomène, son épaisseur 20 nm (devant 1.5 µm) étant inférieure à la taille moyenne des particules abrasives et joue le rôle de filtre par rapport aux particules abrasives transportées par la bande. Nous proposons donc de réaliser le second pôle en alternant un matériau de dureté comparable avec le substrat (tel que le Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> par exemple), avec des couches magnétiques d'épaisseur x suffisamment faibles pour réduire suffisamment cette usure différentielle à un niveau acceptable. Nous réalisons ainsi, à l'échelle des phénomènes abrasifs, un matériau magnétique, mécaniquement dur. Le nombre de périodes n étant définit de telle manière que le produit n x soit égal à l'épaisseur de matériaux magnétiques nécessaires pour que le deuxième pôle puisse continuer de remplir son rôle de fermeture du flux et de blindage magnétique.

Le choix des matériaux n'est pas limitatif (au lieu de Fe<sub>x</sub>Si<sub>y</sub>Al<sub>z</sub> notamment, cela pourrait être du Fe<sub>x</sub>Ta<sub>y</sub>N<sub>z</sub> ou tout autre matériau magnétique).

Dans ces conditions, l'invention prévoit que préférentiellement l'épaisseur du matériau le plus mou (Sendust) est inférieure à la taille moyenne des particules abrasives due aux aspérités de la bande et aux poussières générées par celle-ci. La dureté du matériau ainsi réalisée sera celle du matériau le plus dur. Seuls les grains de taille inférieure à cette épaisseur pourront arracher de la matière au matériau mou. Au plus, la profondeur qui sera creusée sera de l'ordre de cette épaisseur.

Les différentes épaisseurs s et n à donner aux deux matériaux de 35 la couche 9 (Sendust et Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) sera le compromis qui permettra de réduire

, 20

25

30

35

suffisamment le rétreint sur la couche 9 sans altérer les propriétés magnétiques requises pour la couche 9 et qui permettra un fonctionnement correct du système.

Celle-ci possédera alors simultanément de bonnes propriétés magnétiques (forte aimantation à saturation, faible champ coercitif, anisotropie bien contrôlée ...) et une dureté ou résistance à l'abrasion supérieure à celle du matériau magnétique de base. Nous combinons de cette manière les propriétés mécanique de dureté du Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> et celle magnétique du Sendust et réalisons un matériau dont la résistance aux phénomènes d'abrasion peut être calée en jouant sur les épaisseurs relatives des deux matériaux en présence (jusqu'à 5 nm possibles pour le matériau magnétique).

De plus, comme cela est représenté sur la figure 6, la tête de lecture peut présenter des caractéristiques supplémentaires.

Notamment, la couche magnéto-optique 11 peut être réalisée sur un substrat 60 en SGGG avec une couche adhésive intermédiaire 61. De plus une couche réflectrice 63 peut être prévue entre la couche d'entrefer 10 et l'ensemble 9 de l'alternance de couches, toute la lumière du faisceau de lecture n'étant pas réfléchie par la couche 11. Cette couche réflectrice a pour objet d'augmenter la réflexion de la fraction du faisceau ayant traversé ce pôle de lecture. L'indice de la couche d'entrefer est choisi de manière à ce que les faisceaux réfléchis se superposent en étant en phase.

Enfin, une couche de protection de quelques micromètres d'épaisseur 64 en Nitrure de Silicium est prévue sur l'empilement de couche 9.

A titre d'exemple, un mode de réalisation détaillé correspondant à la figure 7 permet d'obtenir une tête de lecture dont les différentes couches présentent les caractéristiques suivantes :

- Substrat 60 : en GGG
- Couche adhésive 61 : en Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, épaisseur 2,5 nm
- Couche magnéto-optique 11 : en Sendust, épaisseur 25 nm
- Couche d'entrefer 10 : en Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub>, d'indice n compris entre 2 et 3,5 et d'épaisseur 200 nm
- Couche adhésive 62 : en Sendust, d'épaisseur 2,5 nm
- Couche réflectrice 63 : en Cuivre ou en Or, d'épaisseur 50 nm

10

15

20

25

30

- Couche magnétique 9 : empilement de quelques dizaines (30 par exemple) de couches de Sendust (épaisseur comprise entre 10 et 50 nm, par exemple 30 nm) alternées avec quelques dizaines (30 par exemple) de couches de Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub> de quelques dizaines de nm, 20 nm par exemple
- Couche de protection 64 en Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub> d'épaisseur quelques μm (1 à 5).

Nous allons maintenant décrire un exemple de procédé de fabrication d'une telle tête de lecture. Ce procédé comprend les trois phases principales suivantes :

- le dépôt des différentes couches magnétiques, diélectriques et réflectrices, qui permettent la réalisation de la tête magnétique et de la structure optique résonnante Fabry-Pérot;
- le dépôt de la couche de protection Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> de quelques μm d'épaisseur (1 à 5) qui est suivi du recuit sous champs magnétique des couches;
- la découpe, le polissage et les traitements antireflet et protecteurs des différentes faces du prisme constituant le composant.

Dans la technologie actuelle toutes les couches sont déposées par pulvérisation cathodique dans un bâti dont la pression du vide est de l'ordre de quelques dizaines de nanoTorr. Ce bâti permet de réaliser des dépôts en DC et en RF, en magnétron et en diode, ces dépôts pouvant être réalisés sous champ magnétique. Les cibles ont un diamètre de 100 mm et la distance de dépôt est de 15 cm ce qui permet de déposer des couches dont l'épaisseur a une homogénéité de l'ordre de 2 à 3 % sur des wafers de 2 pouces de diamètres.

Le choix du substrat sur lequel sont réalisés les dépôts est important. Sa position d'interface optique (couplage de lumière dans le pôle de lecture) et mécanique (contact avec la bande) ainsi que le rôle de radiateur qu'il doit assurer (évacuation de la chaleur déposée par la source laser) imposent un certain nombre de contraintes sur ses propriétés physiques. Ces contraintes sont :

10

15

25

30

- transmettre un maximum de lumière vers le pôle de lecture et vers le photodétecteur donc être transparent à la longueur d'onde du laser utilisé;
- ne pas modifier l'état de polarisation de l'onde électromagnétique lors de la traversée du substrat donc être faiblement biréfringent;
- évacuer efficacement la chaleur résultant de l'absorption par le milieu magnéto-optique de l'onde électromagnétique incidente et qui dégradent les propriétés magnétiques de la couche de lecture donc être un bon conducteur de la chaleur;
- éviter une usure trop rapide du méplat donc être suffisamment dur;
- être facilement usinable et présenter une résistance mécanochimique compatible avec les conditions d'utilisation du système.

L'ensemble de ces contraintes peut conduire à choisir un substrat réalisé dans un monocristal de la famille des grenats, par exemple un grenat de formule générique Gd<sub>3</sub>Ga<sub>5</sub>O<sub>12</sub>.

Les dépôts sont réalisés sur des substrats dont les deux faces sont déjà polies. Ces faces ont une rugosité de l'ordre de 5 Å. Les substrats font 2 pouces de diamètre et ont une épaisseur de 3 mm. Il existe également des substrats de 3 pouces de diamètre qui possèdent les mêmes caractéristiques physiques, surtout en ce qui concerne l'homogénéité des propriétés optiques.

Avant de réaliser la séquence de dépôt, il convient de nettoyer le substrat. Les différentes étapes de nettoyage sont les suivantes :

Le substrat est plongé dans trois bains successifs de trichloréthylène, d'acétone et de propanol. Chacun de ces bains dure 3 minutes. Les bains sont à une température de 60°C et sont agités par ultrasons. Après ce nettoyage mécano-chimique, le substrat est introduit dans le bâti de dépôt. A l'intérieur du bâti, avant de débuter le dépôt des couches, nous réalisons un ultime nettoyage par etching plasma. Nous pouvons alors lancer la séquence de dépôt des différentes couches constituant l'empilement.

15

20

25

30

Le procédé de dépôt commence par le dépôt d'une couche d'alumine de 2,5 nm d'épaisseur. Le rôle de cette couche est d'assurer l'adhérence sur le substrat de la couche suivante.

On dépose alors le premier pôle magnétique (couche 11) appelé pôle de lecture et sur lequel se réfléchit le faisceau laser. Le matériau utilisé pour réaliser cette couche est le Sendust, son épaisseur est de 25 nm. La fonction de cette couche est double, elle doit d'une part, capter efficacement le champ magnétique généré par la bande, d'autre part, convertir le plus efficacement possible les variations d'aimantations en variations de polarisations. Cette couche doit donc posséder des propriétés magnétiques correctes et avoir un coefficient magnéto-optique le plus élevé possible. Les conditions de dépôt ainsi que la composition chimique du matériau ont donc été adaptées pour répondre à ces exigences.

On réalise ensuite le dépôt d'une couche diélectrique et d'une couche réflectrice de Cuivre ou d'Or. La fonction de cet ensemble de couches est également double. Il doit non seulement servir de gap magnétique mais aussi de structure otique résonnante Fabry-Perot, le rôle de cette structure étant d'améliorer le couplage de l'onde incidente avec la couche magnéto-optique et de récupérer la rotation Faraday générée lors de la traversée de cette couche par l'onde électromagnétique. Ainsi, les caractéristiques physiques et géométriques de ces deux couches définissent la densité de lecture et la qualité de la résonance. Un choix judicieux des indices et des épaisseurs des différentes couches permet de régler ces deux paramètres de manière optimale. Dans le cas d'une tête devant relire des bits de 0.4 micron, pour une onde laser de 780 manomètres et à 45° d'incidence, la couche diélectrique doit avoir une épaisseur de 1 900 Å et un indice de réfraction proche de 2, le réflecteur pouvant être une couche de Cuivre ou d'Or de 500 Å d'épaisseur. La couche diélectrique est réalisée à partir d'une cible de Silicium, le dépôt étant fait en présence d'un mélange d'Azote et d'Argon. Nous obtenons ainsi un composé proche du Nitrure de dont les proportions de Silicium et d'Azote dépendent Silicium, essentiellement de la concentration en Azote.

Vient ensuite le dépôt du deuxième pôle (couche 9) permettant de fermer le flux et faisant également office de blindage magnétique. Le

20

25

30

matériau utilisé est le même que celui du pôle de lecture et ce en raison de ses propriétés magnétiques.

Ce deuxième pôle est constitué d'un empilement de 30 périodes de 30 nm de Sendust et de 20 nm de Nitrure de Silicium. Cette structure bien qu'augmentant le temps de dépôt permet de réduire le rétreint de ce pôle lors du passage de la bande. Ce deuxième pôle 9 est donc réalisé en un matériau artificiel combinant les propriétés magnétiques du Sendust et celles de résistance à l'abrasion du Nitrure de Silicium.

Ensuite, on dépose une couche de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> de quelques micromètres d'épaisseur environ dont le rôle est de protéger l'ensemble des dépôts. Le tout est ensuite introduit dans un four de recuit sous champ magnétique permettant d'améliorer les propriétés magnétiques du composant (diminution du champ coercitif et induction d'une anisotropie magnétique dan les pôles de lecture et de fermeture du flux.

Viennent ensuite les différentes étapes de découpe et de polissage des prismes. Nous commençons par découper le substrat en barrettes de 5 mm de large puis nous procédons aux polissages des différentes faces B, D correspondant respectivement aux faces de sortie et de réflexion totale du faisceau puis nous réalisons le méplat M par un polissage sur bandes abrasives.

Les figures 7a, 7b représentent une variante de réalisation de l'invention dans laquelle une contre-plaque 66 est prévue pour assurer un contact correct des couches de lecture (9, 10, 11) avec la bande. Cette contre-plaque peut être collée à la couche magnétique 11 ou à la couche de protection 10b.

On obtient ainsi un empilement de couches tel que représenté en figure 7a qui permet de réaliser, par exemple, la tête de lecture de la figure 7b.

Le rôle de cette contre-plaque qui peut être considéré comme un deuxième substrat est d'une part d'augmenter la largeur du méplat en contact avec la bande, d'autre part de localiser les couches 9, 10, 11 de la tête au centre de la face active (méplat M), réduisant la vitesse d'usure du méplat M et simplifiant le positionnement et le maintien de la tête sur le média comme cela sera expliqué ci-après.

Nous allons donc maintenant expliquer la fonction de la contreplaque 66.

Cette contre-plaque permet de réaliser une géométrie du méplat permettant d'améliorer le contact et le réglage de la tête sur la bande magnétique et de réduire considérablement les contraintes de fabrication pesant sur les tolérances de la partie de la tête de lecture en contact avec la bande.

Dans les têtes actuelles, les éléments et paramètres principaux caractérisant le contact de la tête avec la bande magnétique sont les suivants (figures 8a à 8c) :

### Pour le système :

- l'angle de wrap a, de l'ordre de 0.5°,
- la distance 2D séparant les guides, de l'ordre de 10 mm.
- l'enfoncement h de la tête dans la bande, de l'ordre de 50 μm,
- la tension T de la bande.

### Pour le méplat :

20

25

15

10

- la largeur C, de l'ordre de 100 µm,
- le rayon de courbure R de l'ordre de 5 mm,
- sa composition, celui étant constitué de matériaux d'épaisseur et de dureté différentes,
- la position de la zone active de la tête sur le méplat, les pôles de blindage/fermeture du flux et de lecture se trouvant respectivement à des distances d2 et d1 de 3 et à 5 µm du bord du méplat.

Ses différents paramètres ne sont pas indépendants et sont reliés par les relations suivantes :

h = Da

C = 2Ra

Compte tenu des contraintes liées à l'encombrement du système (paramètre D), à la réalisation du méplat (paramètres R et C) et à la qualité

du contact (paramètres a et h), les valeurs données ci-dessus sont un bon compromis (D, a et h).

Cependant cette géométrie présente les inconvénients majeurs suivants :

- concernant le contact :

Un des premiers problèmes est lié au fait que les couches magnétiques se trouvent à l'extrémité (figure 1c) du méplat. Ce dispositif rend critique le positionnement de la tête sur la bande (paramètres h, D et w) et impose de fortes tolérances sur la fabrication du méplat (paramètres R et C).

Evaluons ces contraintes. Calculons dans un premier temps, l'intervalle de valeur dans lequel doit se situer l'enfoncement h de la tête dans la bande pour qu'il y ait contact. Sur les figures 9a-9b, nous voyons que si l'enfoncement h est insuffisant, il n'y aura pas contact avec la zone active à l'opposé si celui-ci est trop important la bande sera en porte-à-faux sur les bords du méplat, la pression exercée alors par la bande sera beaucoup plus forte dans la zone de contact ce qui entraînera une usure accélérée de la portion du méplat en contact avec la bande. Ainsi, le dernier point de contact Cd, Cd1 et Cd2 entre la bande et le méplat doit être compris entre les points C1 et C2, cela définit deux largeurs de contact de la bande avec le méplat soit C et C-2 d2. L'enfoncement h associé à cet intervalle se calcule aisément à l'aide des formules précédentes et nous obtenons :

 $h = CD/2R (1-d2/C) \pm Dd2/2R = hmed \pm hint$ 

hmed est la valeur nominale de l'enfoncement, hint est la marge de réglage sur cet enfoncement et doit être inférieure aux incertitudes de réglage et de fabrication. Evaluons ces différentes incertitudes.

30 - incertitude de fabrication du méplat :

$$hfab = CD/2R (Ri/R+Ci/C)$$

- incertitude de positionnement de la tête :

20

25

10

15

20

25

30

latéralement : hlat : CD/2R Di/D
angulairement : hang = D wi

• en enfoncement : hiz

soit : hpos = CD/2R Di/D + hiz + D wi

Nous obtenons donc la relation suivante :

CD/2R Di/D + hiz + D wi + CD/2R (Ri/R+Ci/C)<Dd2/2R

avec les données précédentes nous obtenons hint = 1.5 µm

Si nous supposons que nous sommes capables de garantir des côtes à 1 % près pour le méplat (ce qui correspond à une tolérance de 50 µm sur le rayon de courbure et de 1 µm sur la largeur), nous obtenons une valeur pour hfab de 1 µm, cela entraîne qu'il faille garantir le positionnement de la tête à 0.5 µm, ce qui extrêmement difficile à obtenir. En pratique on tolère qu'il y ait un espacement z entre la tête et la bande. Cet espacement introduire une perte p du signal dont l'expression en dB est :

 $p = 55 z/lm = 55 d^2/R/lm soit d = V(p R lm/55)$ 

où d est la distance du dernier point de la bande en contact avec le méplat, lm la longueur d'onde magnétique du signal à lire, les valeurs étant données en micron.

Si nous acceptons de perdre 1 dB sur le signal lu à 0.8 µm, nous obtenons d = 8.5 µm. La marge de réglage hint est alors de 5 µm. Malgré cela, pour être dans la zone de fonctionnement voulue, il faut être capable de repositionner la tête avec une précision sur l'enfoncement de 1 µm et sur l'azimut de 2' et de maintenir la bande lors de son défilement devant la partie active de la tête dans le même domaine de variation (hband<1 µm) ce qui nécessite une mécanique de précision donc coûteuse.

Nous voyons donc que dans cette géométrie réaliser un contact correct avec la bande se traduira par des coûts de fabrication du composant

élevé et par une mécanique perfectionnée et cela alors même que nous tolérons une perte de 1dB sur le signal.

Selon l'invention, on prévoit donc pour relâcher les contraintes de fabrication et de positionnement de la tête de symétriser la position des 5 couches actives par rapport aux bords du méplat (figure 10). Nous réalisons cela en collant une contre-plaque 66 de même nature que le substrat 60 sur les couches. Nous voyons sur la figure 10 que la marge de réglage hint peut être choisie de manière à rendre les contraintes pesant sur la précision du réglage de la tête par rapport à la bande et sur les tolérances de réalisation du méplat aussi faible que nécessaire. Par exemple pour un méplat de 1 500 μm, dont la surface de contact avec la bande est comprise entre 500 μm et 1 100 µm, nous obtenons une marge de réglage hint sur l'enfoncement de ± 150 µm, et cela sans perte de signal et sans que la bande ne vienne frotter sur le bord du méplat, ce qui permet également de relâcher la qualité du polissage dans cette zone (éclat non gênant).

Selon une variante de réalisation de la tête de lecture selon l'invention, on prévoit d'intercaler entre le substrat 60 et la couche magnétooptique 11, une couche Silicium permettant d'améliorer le couplage du faisceau de lecture dans la couche magnéto-optique 11. Expérimentalement, on constate un doublement du facteur de mérite de la tête de lecture permettant d'obtenir un gain d'un facteur quatre sur le débit de lecture. Cette amélioration peut être appliquée en soi à une tête de lecture magnétooptique indépendamment du reste de l'invention. De la même façon, l'invention pourrait être appliquée à un support magnéto-optique dans lequel la couche magnéto-optique serait réalisée sur une couche de Silicium.

Selon une autre variante, pour maximiser le facteur de mérite magnéto-optique en fonction de la dimension de l'entrefer de la tête de lecture on prévoit d'ajuster la valeur de l'indice de réfraction du matériau d'entrefer 10 en faisant varier la concentration en Azote lors de la pulvérisation permettant de caler le pic de résonance magnéto-optique sur l'épaisseur déposée. Il est ainsi possible de faire varier continûment l'indice de la couche d'entrefer entre 3,7 et 2, le matériau passant progressivement de la composition Silicium seul au Nitrure de Silicium.

15

20

25

15

20

25

30

### REVENDICATIONS

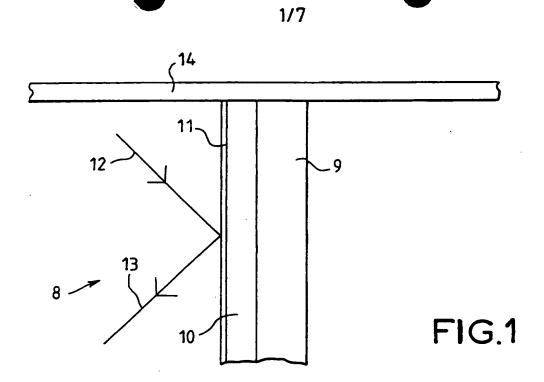
- 1. Tête de lecture magnéto-optique, caractérisée par le fait qu'elle comporte un transducteur magnéto-optique à structure multicouches (9 à 11) à au moins une couche magnétique mince à effet magnéto-optique (11), au moins une couche en matériau non magnétique (10) et présentant un coefficient d'usure déterminé supérieur à celui de 9 et une couche à bonne perméabilité magnétique (9) de fermeture de circuit magnétique, caractérisée en ce que la couche à bonne perméabilité magnétique comprend une alternance de premières sous-couches (91, 93) en matériau magnétique à bonne perméabilité magnétique et de deuxièmes sous-couches (92, 94) en matériau présentant un coefficient d'usure sensiblement équivalent audit coefficient d'usure de la couche en matériau non magnétique (10).
- 2. Tête de lecture selon la revendication 1, caractérisée en ce que les premières sous-couches (91, 93) sont en matériau similaire à celui de la couche magnétique mince à effet magnéto-optique (11).
- 3. Tête de lecture selon la revendication 1, caractérisée en ce que les deuxièmes sous-couches (92, 94) sont en matériau similaire à celui de la couche en matériau non magnétique (10).
- 4. Tête de lecture selon la revendication 2, caractérisée en ce que la couche à effet magnéto-optique (11) est en matériau à base de Fer, de Silicium et d'Aluminium ( $Fe_xSi_yAl_z$ ) ou à base de Fer, Tantale et Azote ( $Fe_xTa_vN_z$ ).
- 5. Tête de lecture selon la revendication 3, caractérisée en ce que la couche en matériau non magnétique (10) est en matériau à base de Silicium et d'Azote (Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub>).
- 6. Tête de lecture selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'épaisseur des premières sous-couches est inférieure au diamètre des grains provenant de l'usure des matériaux de la tête de lecture ou d'un support à lire.
- 7. Tête de lecture selon la revendication 6, caractérisée en ce que l'épaisseur des premières sous-couches est comprise entre 10 et 50 nm.
- 8. Tête de lecture selon la revendication 7, caractérisée en ce que l'épaisseur des deuxièmes sous-couches est de quelques dizaines de nanomètres.

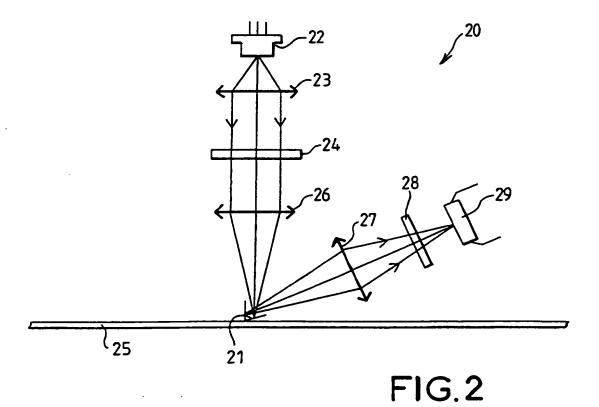
- 9. Tête de lecture selon la revendication 8, caractérisée en ce qu'elle comporte quelques dizaines de premières sous-couches qui alternent avec quelques dizaines de deuxièmes sous-couches.
- 10. Tête de lecture selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comporte une couche réflectrice (63) située entre la couche non magnétique (10) et la couche de bonne perméabilité magnétique (11).
  - 11. Tête de lecture selon la revendication 10, caractérisée en ce que la couche réflectrice est en Or ou en Cuivre.
- 12. Tête de lecture selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comporte une couche d'un matériau de couplage optique accolée à la couche à effet magnéto-optique (11).
  - 13. Tête de lecture selon la revendication 12, caractérisée en ce que la couche de couplage optique est en Silicium.
- 14. Tête de lecture selon la revendication 1, caractérisée en ce que la couche de bonne perméabilité magnétique (9) est recouverte d'une couche de protection (64) sur sa face opposée à la couche de matériau non magnétique (10).
  - 15. Tête de lecture selon la revendication 14, caractérisée en ce que la couche de protection (64) est en Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub>.
  - 16. Tête de lecture selon l'une des revendications 1 ou 14, caractérisée en ce qu'elle comporte une contre-plaque (66) collée à la couche de bonne perméabilité magnétique (9) ou à la couche de protection (64).
  - 17. Tête de lecture selon la revendication 16, caractérisée en ce que la couche à effet magnéto-optique (11) est supportée par un substrat (60), le flanc de l'empilement de couches comprenant notamment :
    - un substrat (60);
    - une couche à effet magnétique (10);
    - une couche à bonne perméabilité magnétique (9);
    - une contre-plaque (66)

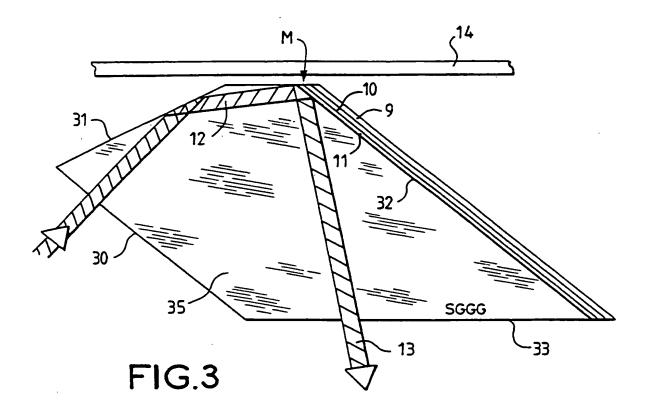
constitue la face active de la tête magnétique et en ce que les épaisseurs de la contre-plaque (66) et du substrat (60) mesurées sur ledit flanc sont sensiblement égales.

30

20







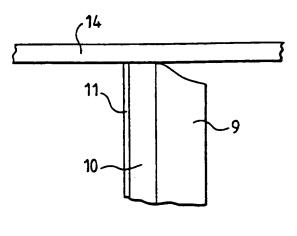


FIG.4a

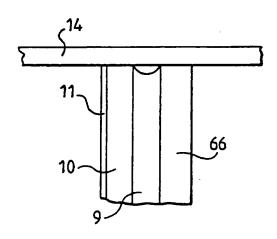
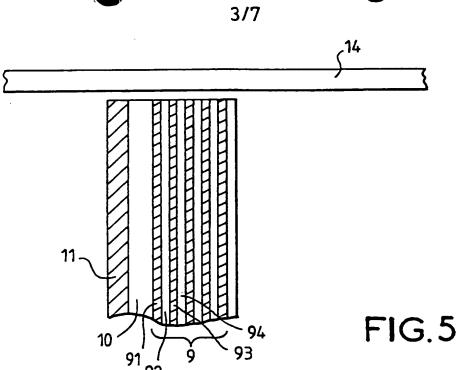


FIG.4b



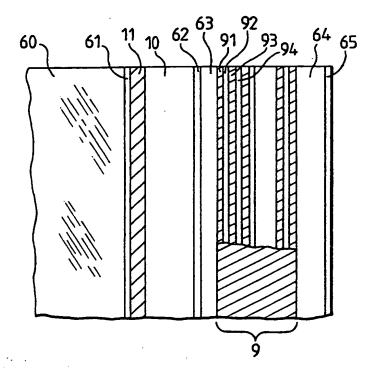
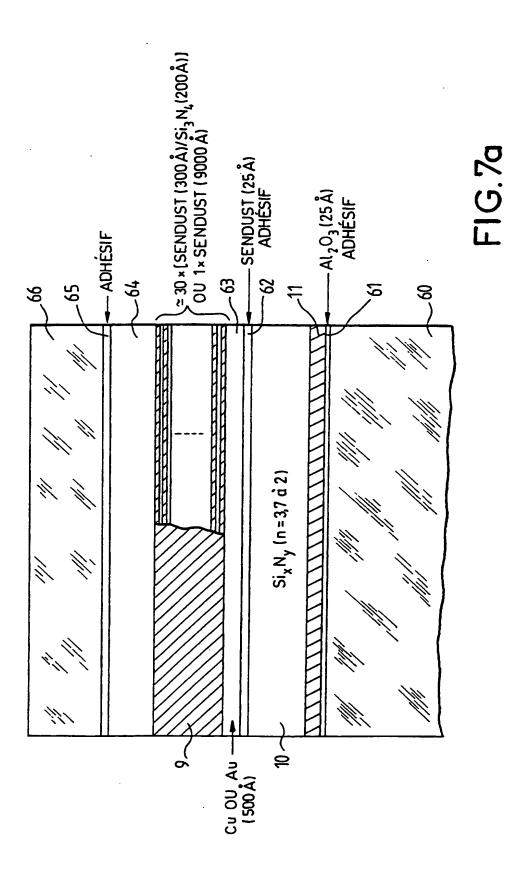
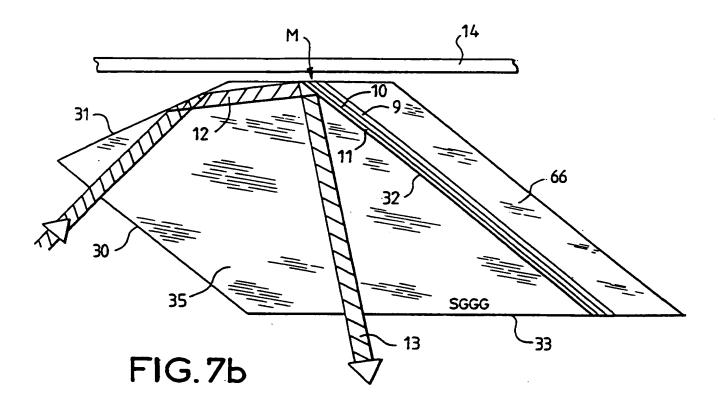


FIG.6





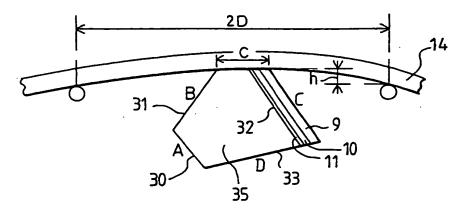


FIG.8a

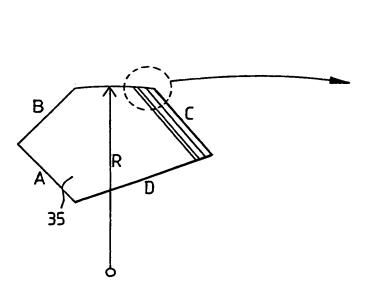


FIG.8b

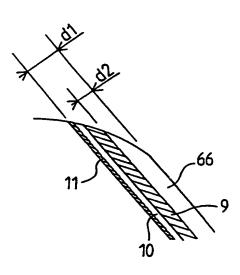
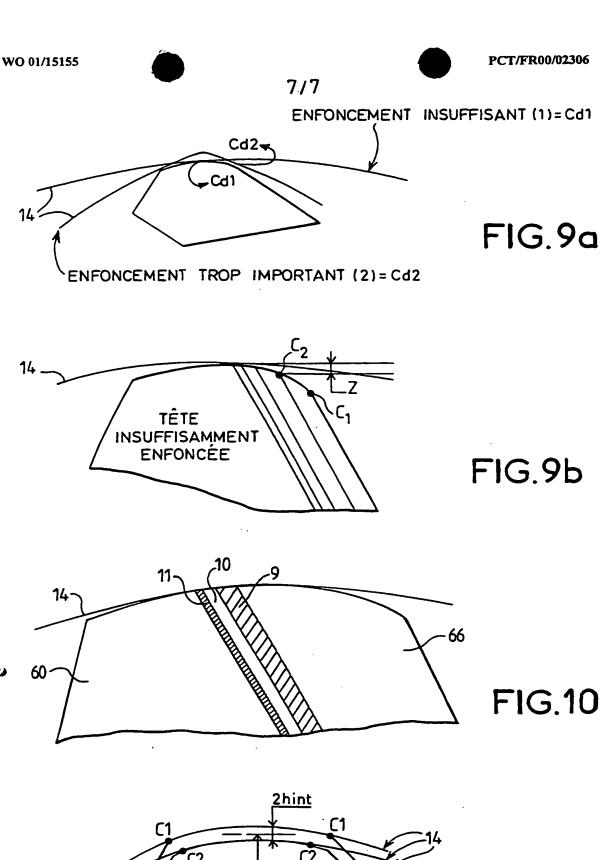
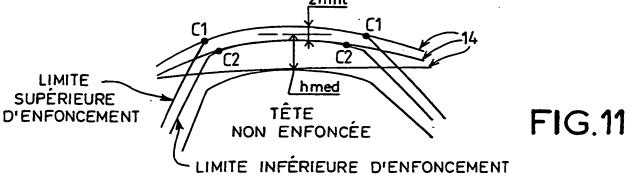


FIG.8c





THIS PAGE BLANK (USPTO)



tratern al Application No PCT/FR 00/02306

A. CLASSIF IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G11B11/105				
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC			
— <u> </u>	SEARCHED				
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification $G11B$	ion symbols)			
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields searched			
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical search terms used)			
EPO-In	ternal, PAJ				
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages Relevant to claim No.			
A	EP 0 436 424 A (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS) 10 July 1991 (1991- cited in the application column 3, line 1 - line 30	07-10)			
A	EP 0 527 670 A (THOMSON CSF) 17 February 1993 (1993-02-17) column 4, line 28 -column 5, line	1 2 17			
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.			
*A' docume consid  *E' earlier of filing of  *L' docume which citatio  *O' docume other of the constant of the	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent reterring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	"T' later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "8." document member of the same patent family			
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report			
	December 2000	11/12/2000			
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer			
Name and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Risswijk					
1	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo n!, Fax: (+31-70) 340-3016	Nanos, A			

THIS PAGE BLANK (USPTO)





....rmation on patent family members

Intern al Application No PCT/FR 00/02306

Patent document cited in search repor	t	Publication date	1	Patent family member(s)	Publication date
EP 0436424	Α	10-07-1991	FR	2656723 A	05-07-1991
			AT	142817 T	15-09-1996
			CA	2047185 A	29-06-1991
			DE	69028510 D	17-10-1996
			DE	69028510 T	06-02-1997
			DK	436424 T	03-03-1997
			ES	2091234 T	01-11-1996
			WO	9110234 A	11-07-1991
			GR	3021145 T	31-12-1996
			JP	4504922 T	27-08-1992
			KR	230668 B	15-11-1999
			US	5689391 A	18-11-1997
EP 0527670	Α	17-02-1993	FR	2680268 A	12-02-1993
<u>-</u> , -,-,-,-			DE	69227486 D	10-12-1998
			DE	69227486 T	15-04-1999
			EP	0844604 A	27-05-1998
			JP	6180883 A	28-06-1994
			US	5392181 A	21-02-1995

THIS PAGE BLANK (USPTO)